

ポスター発表 プログラム (14日(金)発表)

Poster	論文のタイトル	著者	所属
FR01	AIN溶液成長に向けたLi3N-AI擬二元系状態図解析	屋山 巴(1), 寒川 義裕(1, 2, 3), 柿本 浩一(1, 2)	1)九大院工、2)九大応研、3)JST PRESTO
FR02	Si(111)上の吸着窒素原子によるβ-Si3N4成長とAl照射による界面反応エピタキシーAIN成長	山邊信彦、山本由香、大鉢忠	同志社大理工
FR03	RF-MBEプラズマ窒素源の窒素原子フラックスその場計測	大鉢忠1, 山邊信彦1, 山本由香1, 和田元1, 有屋田修2	同志社大理工1、アリオス1
FR04	単結晶AINの格子定数の温度依存性	酒井美希1, 田島純平1, 永島徹2, 富樫理恵1, 村上尚1, 森岡仁3, 山内剣3, 齋藤啓介3, 熊谷義直1, 高田和哉2, 瀧澤明伯1	1農工大院工, 2(株)トクヤマ, 3ブルカー・エイエックスエス(株)
FR05	r面sapphire基板上a面AIN HVPE成長初期過程におけるキャリアガスの影響	田島 純平 <sup>1</sup> , 富樫 理恵 <sup>1</sup> , 村上 尚 <sup>1</sup> , 高田 和哉 <sup>2</sup> , 熊谷 義直 <sup>1</sup> , 瀧澤 明伯 <sup>1</sup>	農工大院工 <sup>1</sup> , (株)トクヤマ <sup>2</sup>
FR06	SiC基板上への減圧HVPE法によるクラックフリーAIN成長	三重大工 <sup>1</sup> , 名工大工 <sup>2</sup> 奥村建太 <sup>1</sup> , 三宅秀人 <sup>1</sup> , 平松和政 <sup>1</sup> , 江龍修 <sup>2</sup>	三重大院工 <sup>1</sup> , 名工大院工 <sup>2</sup>
FR07	減圧HVPE法によるAIN成長におけるポイド形成制御	藤田浩平 <sup>1</sup> , 奥浦一輝 <sup>1</sup> , 三宅秀人 <sup>1</sup> , 平松和政 <sup>1</sup> , 乗松潤 <sup>2,3,4</sup> , 平山秀樹 <sup>2,4</sup>	三重大院工、理研、埼玉大、JST-CREST
FR08	MOVPE法によるサファイア基板上へのAIN成長における界面制御	宮川鈴衣奈、三宅秀人、平松和政	三重大院工
FR09	SiCナノ表面上のAIN成長初期過程	石山 裕策, 萩原 好人, 田中 悟	九大院工
FR10	6H-SiC(0001)基板のステップ端を起因とする2H-AIN成長層の貫通刃状転位列の発生機構とGa先行照射によるその抑制	奥村宏典、木本恒暢、須田淳	京大院工
FR11	MgドープAIN下地層を用いた高品質厚膜AlGaInの微細構造観察	野中健太郎 <sup>1</sup> , 浅井俊晶 <sup>1</sup> , 伴和仁 <sup>1</sup> , 岩谷素顕 <sup>1</sup> , 上山智 <sup>1</sup> , 天野浩 <sup>1</sup> , 赤崎勇 <sup>1</sup> , Zhihao Wu <sup>2</sup>	1名城大理工 2華中科技大
FR12	Si-doped AlGaInのMOVPE成長と紫外光源応用	島原 佑樹 <sup>1</sup> , 武富 浩幸 <sup>1</sup> , 三宅 秀人 <sup>1</sup> , 平松 和政 <sup>1</sup> , 福世 文嗣 <sup>2</sup> , 岡田 知幸 <sup>2</sup> , 高岡 秀嗣 <sup>2</sup> , 吉田 治正 <sup>2</sup>	三重大工 <sup>1</sup> , 浜松ホトニクス <sup>2</sup>
FR13	高Al組成AlGaInのMBE成長におけるGa取り込みの極性面と無極性面の大きな相違	上田俊策、堀田昌宏、木本恒暢、須田淳	京大院・工
FR14	UVレーザダイオードの閾値電流密度の低減	永田賢吾 <sup>1</sup> , 野中健太郎 <sup>1</sup> , 市川友紀 <sup>1</sup> , 竹田健一郎 <sup>1</sup> , 岩谷素顕 <sup>1</sup> , 上山智 <sup>1</sup> , 天野浩 <sup>1</sup> , 赤崎勇 <sup>1</sup> , 吉田治正 <sup>2</sup> , 桑原正和 <sup>2</sup> , 山下陽滋 <sup>2</sup> , 菅博文 <sup>2</sup>	名城・理工 <sup>1</sup> , 浜松ホトニクス <sup>2</sup>
FR15	MQBを用いた高効率250nm帯AlGaIn系深紫外LED	平山秀樹、塚田悠介、前田哲利、鎌田憲彦	理研、埼玉大理工、JST-CREST
FR16	AlGaIn深紫外LEDの電子注入効率改善のためのMQB設計	塚田悠介、平山秀樹、前田哲利、鎌田憲彦	理研、埼玉大理工、JST-CREST
FR17	Si基板上280nm帯InAlGaIn深紫外LEDの実現	藤川紗千恵(1,2)、平山秀樹(1,2)	(1)理研、(2)JST-CREST
FR18	AlGaIn混晶薄膜の偏光特性と局在励起子発光ダイナミクス	室谷英彰 <sup>1</sup> 橋高亮 <sup>1</sup> 山田陽一 <sup>1</sup> 三宅秀人 <sup>2</sup> 平松和政 <sup>2</sup>	1山口大院理工 2三重大院工
FR19	AINテンプレート上にMOVPE法で成長させたAlGaIn層の微細構造のAl組成依存性	藤田 智彰[1]、黒木 拓哉[1]、桑野 範之[1,2]、島原 佑樹[3]、武富 浩幸[3]、三宅 秀人[3]、平松 和政[3]	[1]九大総理工、 [2]九大産学連携セ、 [3]三重大工
FR20	強励起した高Al組成AlGaIn/AIn量子井戸の深紫外発光メカニズム	大音隆男、岩田佳也、金田昭男、Ryan G. Banal, 船戸充, 川上養一	京大院工
FR21	GaN基板を用いた窒化物太陽電池の特性評価	桑原洋介 藤山泰治 森田義己 藤井崇裕 杉山徹 岩谷素顕 上山 智 天野 浩 赤崎勇	名城大 理工
FR22	規則配列InGaIn/GaN MQWナノコラムによる光励起緑色域誘導放出	石沢峻介(1,2,3), 岸野 克巳(1,2,3), 荒木 隆一(1), 菊池昭彦(1,2,3)	(1)上智大理工, (2)上智ナノテク, (3)CREST, JST
FR23	Ga(Gd)N/AlGaIn三重障壁共鳴トンネルダイオード構造の作製と評価	東 晃太郎, 谷 弘敦, 周 逸凱, 長谷川 繁彦, 朝日 一	阪大産研
FR24	半極性、非極性GaNストライプ上InGaIn/GaN MQWのMOVPE成長	谷川智之、本田善央、山口雅史、天野浩	名大
FR25	GaN自立基板上InN/ハイドライド気相成長における基板極性の影響	富樫理恵、村上尚、熊谷義直、瀧澤明伯	農工大院工

ポスター発表 プログラム (15日(土)発表)

Poster	論文のタイトル	著者	所属
SA01	Naフラックス法により作製したm面Ga <sub>N</sub> 基板上へのm面Ga <sub>N</sub> のMOVPE成長の基板オフ角依存性	磯部康裕1、飯田大輔1、岩谷素顕1、上山智1、天野浩1、赤崎勇1、今出完2、北岡康夫2、森勇介2	名城大・理工
SA02	LiNH <sub>2</sub> とGaの反応によるGa <sub>N</sub> の合成	張天 声、杉浦 隆	岐大工
SA03	MOMBEによるGa <sub>N</sub> の選択成長、横方向成長	阿部亮太、林家弘、丸山隆浩、成塚重弥	名城大理工
SA04	BNTCA-BPTAポリマー焼結グラファイトシート上へのGa <sub>N</sub> 薄膜成長	金子俊郎1、太田実雄1、藤岡洋1,2、山下順也3、羽鳥浩章3、児玉昌也3、平崎哲郎4、植仁志4	1 東大生研, 2 JST-CREST, 3 産総研, 4 東海カーボン
SA05	a面Ga <sub>N</sub> 選択成長におけるファセット構造	馬ベイ、三宅秀人、平松和政	三重大院工
SA06	アンモニアガスを用いた液層成長によるGa <sub>N</sub> 薄膜の成長	風間正志、小島春輝、佐藤秀治郎、丸山隆弘、成	名城大学理工学部
SA07	第一原理計算による気相成長法におけるGa <sub>N</sub> (0001)へのV族原料吸着過程の解析	鈴木ひかり、村上尚、熊谷義直、瀧本明伯	農工大院工
SA08	ピラミッド上r面InGa <sub>N</sub> /Ga <sub>N</sub> 多重量子井戸の気相拡散に基づく発光波長変調	藤原達記、中野義昭、杉山正和	東大院工
SA09	異種面で構成された窒化物半導体上の多重量子井戸の評価	岡田成仁、高見成希、宮武敬彰、只友一行	山口大院理工
SA10	6H-SiC(0001)基板上MBE成長高品質AlNテンプレート上に成長したGa <sub>N</sub> 層の結晶性評価	菊地諒介、奥村宏典、木本恒暢、須田淳	京大院・工
SA11	半極性Ga <sub>N</sub> 表面上のMg吸着に関する理論的研究	山下智樹、安味大輔、秋山 亨、中村浩次、伊藤智徳	三重大院工
SA12	Mg-doped Ga <sub>N</sub> (Mg:7x10 <sup>17</sup> ~2x10 <sup>19</sup> cm <sup>-3</sup> ) の深い準位の評価	小川 恵理 <sup>1</sup> 、橋詰 保 <sup>1,2</sup>	北大量集センター <sup>1</sup> 、JST-CREST <sup>2</sup>
SA13	MOVPE法によるIn <sub>0.6</sub> Al <sub>0.4</sub> N/In <sub>0.4</sub> Ga <sub>0.6</sub> Nヘテロ構造の作製	田中 幹康、笹本 紘平、杉田 憲一、橋本 明弘、山本 あき勇	福井大・工
SA14	ZnO基板上への無極性面・半極性面InAlN薄膜の成長	梶間智文 <sup>1</sup> 、上野耕平 <sup>2</sup> 、小林篤 <sup>1</sup> 、太田実雄 <sup>2</sup> 、藤岡洋 <sup>2,3</sup> 、尾嶋正治 <sup>1,3</sup>	1東大院工、2東大生研、3JST-CREST
SA15	GaN晶癖面上に成長したInGa <sub>N</sub> 結晶間の励起移動のCL像観察と発光強度の温度依存	積木秀美 <sup>1</sup> 、佐々木 泰 <sup>1</sup> 、蟹江 壽 <sup>2</sup>	1)東理大院基礎工 2)東理大基礎工
SA16	パルススパッタ法による太陽電池用InGa <sub>N</sub> 薄膜の作製	加藤雅樹 <sup>1</sup> 、田村和也 <sup>1</sup> 、井上茂 <sup>1</sup> 、太田実雄 <sup>1</sup> 、藤岡洋 <sup>1,2</sup>	1 東大生研, 2 JST-CREST
SA17	p-InGa <sub>N</sub> (In組成 ~0.4)のMOVPE成長	堀田 徹 <sup>1</sup> 、笹本 紘平 <sup>1</sup> 、杉田 憲一 <sup>1</sup> 、橋本 明弘 <sup>1</sup> 、山本 高勇 <sup>1</sup> 、木下勝弘 <sup>2</sup> 、小路 泰弘 <sup>2</sup>	1: 福井大・工、2: 関西電力
SA18	Effects of pre-treatment & pre-layer on MOVPE growth of InGa <sub>N</sub>	S. Y. Ji <sup>1,2</sup> , V. Suresh Kumar <sup>1</sup> , Y. H. Liu <sup>1,2</sup> , Y. T. Zhang <sup>1,2</sup> , H. Shindo <sup>1</sup> , R. Katayama <sup>1,2,3</sup> , and T. Matsuoka <sup>1,2</sup>	1. 東北大金研 2. JST-CREST
SA19	InGa <sub>N</sub> 三元混晶のHVPE成長に関する熱力学的考察	花岡幸史、田口悠嘉、村上尚、熊谷義直、瀧本明伯	農工大院工
SA20	ZnO基板から異方的歪みを受けたm面InGa <sub>N</sub> 薄膜の偏光特性	玉木 啓晶 <sup>1</sup> 、小林 篤 <sup>2</sup> 、太田 実雄 <sup>1</sup> 、藤岡 洋 <sup>1,3</sup> 、尾嶋 正治 <sup>2,3</sup>	東大生研 <sup>1</sup> 、東大院工 <sup>2</sup> 、JST-CREST <sup>3</sup>
SA21	SNOMIによるInGa <sub>N</sub> 単一量子井戸の発光強度飽和メカニズム	橋谷 享、金田 昭男、船戸 充、川上 養一	京大院
SA22	DERI法のRHEED強度その場観察手法を用いたラジカルセル診断	勝木拓郎 <sup>1</sup> 、福本英太 <sup>1</sup> 、山口智広 <sup>2</sup> 、荒木努 <sup>1</sup> 、名西やすし <sup>1,3</sup>	立命館大
SA23	窒化インジウム薄膜の加圧MOVPE成長	劉 玉懷 <sup>1,2</sup> 、木村 健司 <sup>1,2</sup> 、張源濤 <sup>1,2</sup> 、平田雅貴 <sup>1</sup> 、紀世陽 <sup>1</sup> 、片山竜二 <sup>1,2</sup> 、松岡隆志 <sup>1,2</sup>	東北大金研 <sup>1</sup> 、JST-CREST <sup>2</sup>
SA24	サファイア(0001)基板上In <sub>N</sub> HVPE成長における成長初期核制御の効果	東川義弘、大竹斐、富樫理恵、村上尚、熊谷義直、瀧本明伯	東京農工大院工